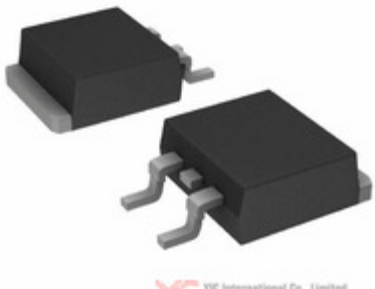









	<p>Hersteller-Teilenummer: IPB097N08N3 G</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 80V 70A TO263-3</p>
	<p>Datenblätter:  IPB097N08N3 G.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 23500 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	IPB097N08N3 G
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 80V 70A TO263-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	23500 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 46µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-2
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9.7 mOhm @ 46A, 10V
Verlustleistung (max)	100W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2410pF @ 40V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	35nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	70A (Tc)

IPB097N08N3 G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB097N08N3 G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB097N08N3 G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPB097N08N3 G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPB09N03LAG INFINEO IPB09N03LAG INFINEO</p>	 <p>IPB09N03 Original IPB09N03 Original</p>	 <p>IPB097N08N3 Infineon IPB097N08N3 Infineon</p>	 <p>IPB09N03LA G Infineon Technologies MOSFET N-CH 25V 50A D2PAK</p>
 <p>IPB096N03L Infineon IPB096N03L Infineon</p>	 <p>IPB09N03LA Infineon Technologies MOSFET N-CH 25V 50A D2PAK</p>	 <p>IPB097N08N3G INFINEON IPB097N08N3G INFINEON</p>	 <p>IPB096N03LGATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 35A TO-263-3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB097N08N3 G International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB097N08N3 G Datenblatt	IPB097N08N3 G-Datenblätter	IPB097N08N3 G PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB097N08N3 G
IPB097N08N3 G Electronic	IPB097N08N3 G-Komponenten	IPB097N08N3 G-Verteiler	IPB097N08N3 G-Bild	IPB097N08N3 G-Teil
IPB097N08N3 G Preis	IPB097N08N3 G Hersteller	IPB097N08N3 G Bild	IPB097N08N3 G Aktie	IPB097N08N3 G Inventar
IPB097N08N3 G Neu	IPB097N08N3 G Original	IPB097N08N3 G garantiert	IPB097N08N3 G RFQ	IPB097N08N3 G Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited